

ELECTRICALLY ERASABLE NONVOLATILE SEMICONDUCTOR STORAGE DEVICE

Publication number: JP4307974

Publication date: 1992-10-30

Inventor: YOSHIMI MASANORI

B11

Applicant: SHARP KK

Classification:

- international: H01L21/8247; H01L27/115; H01L29/788; H01L29/792;
H01L21/70; H01L27/115; H01L29/66; (IPC1-7):
H01L27/115; H01L29/788; H01L29/792

- European:

Application number: JP19910073239 19910405

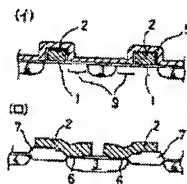
Priority number(s): JP19910073239 19910405

Report a data error here

Abstract of JP4307974

PURPOSE: To contrive an increase in the integration of the title device by a method wherein floating gates are respectively divided functionally into a write site and an erase site and in the sides of the erase sites, a tunnel oxide film is provided to constitute the erase sites without providing a source offset and in the sides of the write sites, a source offset is provided to constitute the write sites.

CONSTITUTION: One pair of L-shaped floating gates 2 consisting of a polysilicon film are respectively provided on gate regions between a source line 3 in the surface of a silicon substrate and one pair of drain lines 4 and 4 arranged on both sides of the line 3 via an insulating film. Moreover, control gates 5 consisting of a polysilicon film to the gates 2 are respectively provided on the gates 2 via an interlayer insulating film. In one pair of write sites, writing using an injection of electrons from the side of each drain to each gate 2 is performed. On the other hand, in the erase sites, erase using an F-N tunneling is performed en bloc from the side of a source to the gates 2 and 2.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平4-307974

(43) 公開日 平成4年(1992)10月30日

(51) Int. Cl. ⁴	識別記号	特許出願番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 29/788				
29/792				
27/115				
	8225-4M	H 0 1 L 29/78	3 7 1	
	6831-4M	27/10	4 3 4	
		審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 4 頁)		

(21) 出願番号	特開平3-73239	(71) 出願人	000005049 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
(22) 出願日	平成3年(1991)4月5日	(72) 発明者	吉見 正樹 大阪府阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
		(74) 代理人	井澤士 野河 昌太郎

(54) 【発明の名称】 電氣的消去可能不揮発性半導体記憶装置

(57) 【要約】

【目的】 ソースオフセットに選択ゲートを構成したE E P R O MにおけるF-Nトンネリングによる消去を円滑化して、素子の微小化を図る。

【構成】 1つのソースラインとその両側のドレインラインとで2つのE E P R O Mセルを構成し、各フローティングゲートの一方側をホットエレクトロンによる書き込み部位とし他方側をF-Nトンネリングによる一括消去部位として機能分離する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】ソース領域とその両側に配置される一対のドレイン領域及びこれらの間で設定される一対のゲート領域、このゲート領域上に配置される一対のフローティングゲート及びこのフローティングゲート上に配置されるコントロールゲートを備え、上記一対の各フローティングゲートが、(a) 各ソースオフセットを介して上記ゲート領域上に位置して一対のドレイン駆動書き込み部を構成する書き込み部位と、(b) 各ソース両側に配置されたトンネル酸化膜上に位置して一つのソース駆動消去部を構成する消去部位、を有してなり、上記コントロールゲートが、上記一対のフローティングゲートの書き込み部位及びソースオフセット上を共通して覆うように配置されてなる電氣的消去可能不揮発性半導体記憶装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】この発明は、電氣的消去可能不揮発性半導体記憶装置(EEPROM)に関する。さらに詳しくは、高集積化に適したEEPROMの素子構造に

【0002】

【従来の技術】従来から、電氣的消去可能不揮発性半導体記憶装置(EEPROM)として種々の構造のものが知られており、いずれもいわゆるフローティングゲートを有し、ホットエレクトロンによる書き込みやF-N(Fowler-Nordheim)トンネリングによる消去/書き込みを利用している。

【0003】そして選択ゲート(セレクションゲート)を有さない、いわゆる初期のスタックゲートEEPROMにおいては、ドレイン側よりホットエレクトロンによる書き込みが行なわれ、ソース側よりF-Nトンネリングによる消去が行なわれる。

【0004】しかしながら、このようにソース側よりF-Nトンネリングより消去する構造では、しばしば漏れ消去が生じてメモリセルがディブリッジ化することがある。

【0005】このため、選択ゲートを組合せて上記漏れ消去を防止することがしばしば行なわれている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、選択ゲートを独立して設けるためメモリセルの占有面積が増加し、EEPROMの集積度が著しく低下する。

【0007】そのため、EEPROMを構成するソースラインとフローティングゲートとの間にオフセットを設け、このオフセット部上に選択ゲートを配置することも考えられる。

【0008】しかしながら、この場合には、オフセットの存在により、ソースとフローティングゲート間のF-Nトンネリングが生じ難く、データの消去を困難に行

なうことができなかった。また、この場合、ドレインとフローティングゲート間のF-Nトンネリングを利用することも考えられるが、これを達成するには、ドレインに比較的高電圧を印加する必要がある。従って、必然的にリーク電流を防止すべくドレイン-ソース間を介するものが要求され、そのためにはドレイン-ソース間の膜厚プロファイルをなだらかにする必要があるが、この場合には、ホットエレクトロンの発生効率が著しくなり、書き込み特性が低下する不都合があった。

【0009】この発明は、かかる状況下なされたものであり、ことにソース側オフセット部に選択ゲートを構成したEEPROMにおいても、ソース側からのF-Nトンネリングによる消去を可能とする構造を提供しようとするものである。

【0010】

【課題を解決するための手段】かくしてこの発明によればソース領域とその両側に配置される一対のドレイン領域及びこれらの間で設定される一対のゲート領域、このゲート領域上に配置される一対のフローティングゲート及びこのフローティングゲート上に配置されるコントロールゲートを備え、上記一対の各フローティングゲートが、(a) 各ソースオフセットを介して上記ゲート領域上に位置して一対のドレイン駆動書き込み部を構成する書き込み部位と、(b) 各ソース両側に配置されたトンネル酸化膜上に位置して一つのソース駆動消去部を構成する消去部位、を有してなり、上記コントロールゲートが、上記一対のフローティングゲートの書き込み部位及びソースオフセット上を共通して覆うように配置されてなる電氣的消去可能不揮発性半導体記憶装置が提供される。

【0011】この発明は、上記課題を解決すべく、フローティングゲートを断続的に書き込み部位と消去部位に分け、消去部位ではソースオフセットを設けることなくトンネル酸化膜を設けて一つの消去部を構成し、書き込み部位ではソースオフセットを設けて一対の書き込み部位を構成するという手段を講じたものである。

【0012】

【作用】ドレイン駆動書き込み部位においては、ソースオフセットが確保されておりこのオフセット上のコントロールゲートを選択ゲートとすることができ、かつホットエレクトロンの注入がオフセットを有しない各ドレイン側から行なわれるため、各々均等な書き込みが行なわれる。

【0013】一方、ソース駆動消去部においてはソースオフセットを有さないため、ソース領域の両側に配置されたトンネル酸化膜を介してソース側からのF-Nトンネリングが行なわれ、均等な消去が一括して行なわれることとなる。

【0014】

【実施例】以下、添付図面に示す実施例に基づいてこの

説明を詳説する。

【0015】図1は、この発明の一実施例のEEPROMを示す平面構成説明図であり、図2(イ)は、図1のA-A'線断面説明図、図2(ロ)は同じくB-B'線断面説明図である。

【0016】これらの図に示すように、この発明のEEPROMは、シリコン基板表面のソースライン3とその両側に配置される一対のドレインライン4、4との間のゲート領域2上に、絶縁膜を介してポリシリコンからなる1対のL字状フローティングゲート2を配設してなり、さらに、このフローティングゲート2上に層間絶縁膜を介して、共通するポリシリコンからなるコントロールゲート5を配設してなる。

【0017】上記フローティングゲート2は、図2(イ)に示すように、A-A'断面においては、ソースオフセット9を保持してゲート領域のゲート酸化膜1、1上に位置する一対の書き込み部位(狭幅部分)を有する。このソースードレイン幅は1.6~2.0 μ m、ソースオフセットは0.8~1.0 μ mとするのが適している。かかる書き込み部位上のコントロールゲート5は、各々のソースオフセット上で選択ゲートとしても機能する。

【0018】一方、図2(ロ)に示すように、B-B'断面においては、ソースライン3の両側に配設されたトンネル酸化膜6上を被覆する消去部位(広幅部分)を有してなる。なお、図中、7は、ロソス酸化膜からなる素子分離領域である。

【0019】かかる構造のEEPROMにおいては、上記一対の書き込み部位において、各々ドレイン側からフローティングゲートへのホットエレクトロンの注入による書き込みが行なわれる。そして、消去部位においては、ソース側から両フローティングゲート2、2へ流してF-Nトンネリングによる潮流が行なわれることとなる。そして、上記ホットエレクトロンの注入及びF-Nトンネリングがコントロールゲートを選択ゲートとして制御されることとなる。

【0020】かかる第1のEEPROMは、例えば以下のようにして作製することができる。まず、図3に示すように、シリコン基板の所定の領域にロソス酸化膜により、素子分離領域7を形成した後、メモリーセルのソース形成ラインのイオン注入及び破壊のイオン注入を行ってDDD構造のソースラインを形成する。表面を熱酸化に付して全面に例えば200~300Å程度のゲート酸化膜1を形成し、フォトリソグラフィのパターニング及びエッチングを行なうことにより、その一部にトンネル酸化膜用窓を形成し、フォトレジストの除去後、熱酸化を行なうことにより、各々、一対のトンネル酸化膜6を形成する。

【0021】次に、CVD法により全面にポリシリコンを堆積し、N型不純物拡散してフォトレッチングするこ

とにより、図5に示すように、各々狭幅領域と広幅領域を有する一対のL字状フローティングゲート2を形成する。

【0022】上記フローティングゲート2の形成後、図6に示されるようにフォトレジスト8を用いたフォトリソグラフィにより、メモリーセルのドレイン形成ラインに破壊をイオン注入してドレインラインを形成する。

【0023】この後、フローティングゲート2の書き込み部位上に各々CVDによる層間絶縁膜(SiO₂)を被覆形成した後、ポリシリコンの堆積膜へのN型不純物拡散及びエッチングを行なうことにより、図7に示すごとく、コントロールゲート5を形成してこの発明のEEPROMが得られる。

【0024】

【発明の効果】以上の様に、この発明のEEPROMによれば、ソース側のオフセット部を選択ゲートとする場合においても、ソース側より行なう消去操作ができるので、独立して消去用ゲートを設ける場合と比べメモリーセル等表面積が著しく減少され、さらなるEEPROMの高集積化を図ることが可能となる。

【0025】さらに、ホットエレクトロンの発生効率の良いドレイン接合及び、消去用の高電圧においてもリーク電流の少ない、ソース接合を別々に最適化できる。従って、ドレイン側よりホットエレクトロンにより書き込み、ソース側よりF-Nトンネリングにより消去する電気的消去可能な非揮発性半導体記憶装置の製造の観点からも、その設計がより容易となり、製造上最も容易となる利点も得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例のEEPROMの平面構成説明図である。

【図2】(イ)は、図1のA-A'線断面説明図、

(ロ)は、B-B'線断面説明図である。

【図3】図1のEEPROMの製造工程を示すレイアウト図である。

【図4】図3に続くレイアウト図である。

【図5】図4に続くレイアウト図である。

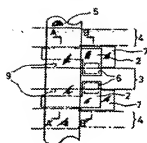
【図6】図5に続くレイアウト図である。

【図7】図6に続くレイアウト図である。

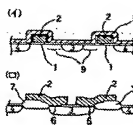
【符号の説明】

- 1 ゲート酸化膜
- 2 フローティングゲート
- 3 ソースライン
- 4 ドレインライン
- 5 コントロールゲート
- 6 トンネル酸化膜
- 7 素子分離領域
- 8 フォトレジスト
- 9 ソースオフセット

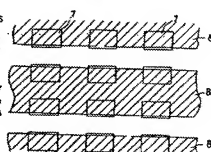
【図1】



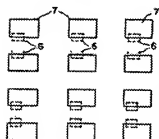
【図2】



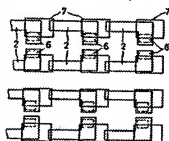
【図3】



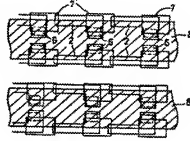
【図4】



【図5】



【図6】



【図7】

